

ИЗВЕСТИЯ

ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

Том 248

1975

СРАВНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИДЕАЛИЗИРОВАННЫХ ИНТРОСКОПОВ НА РЕНТГЕНОВИДИКОНАХ С МИШЕНЯМИ ИЗ СЕЛЕНА И ОКИСИ СВИНЦА

А. П. ШПАГИН, В. С. ДЕРКАЧ

(Представлена научным семинаром НИИ электронной интроскопии)

Приведены результаты расчетов зависимостей отношений сигнал/шум для идеализированных интроскопов на рентгеновидиконах с мишениями из селена и окиси свинца для двух толщин мишени в области энергий моноэнергетического излучения 20÷200 кэв.

Чувствительность интроскопа определяется совместным влиянием всех его звеньев, параметров этих звеньев и процессами, проходящими в них. В частности, для интроскопа с рентгеновидиконом чувствительность определяется изменением доли поглощенной в мишени энергии излучения, электрофизическими свойствами мишени, ее геометрией, способом считывания потенциального рельефа, шумами усилителей и параметрами воспроизводящей аппаратуры. Чувствительность интроскопа может быть охарактеризована отношением сигнал/шум, обеспечиваемым данным интроскопом при просвечивании эталонного дефектометра, например, канавочного дефектометра с определенным отношением глубины канавки к толщине дефектометра.

Для анализа интроскопа и определения влияния отдельных его параметров на чувствительность целесообразно канал передачи информации в интроскопе разделить на последовательные самостоятельные этапы и произвести анализ каждого этапа. В интроскопе с рентгеновидиконом к первому этапу можно отнести преобразование модулированного потока гамма-излучения в распределение поглощенной в мишени энергии. Ко второму этапу — преобразование распределения поглощенной энергии в потенциальный рельеф на внутренней поверхности мишени и к третьему этапу — преобразование потенциального рельефа в видеосигнал и обработка видеосигнала.

На каждом этапе преобразования информации возникают дополнительные шумы, что эквивалентно уменьшению отношения сигнал/шум, а следовательно, и чувствительности интроскопов.

Целью данной работы является оценка влияния материала мишени на первый этап преобразования информации в рентгеновидиконном интроскопе. Эту оценку можно произвести на основе сравнения отношения сигнал/шум идеализированных интроскопов, характеризующихся тем, что все этапы преобразования, кроме первого, не вносят дополнительных шумов, т. е. отношение сигнал/шум на выходе интроскопа равно отношению сигнал/шум после первого этапа преобразования. При этом удобно принять отношение сигнал/шум на входе интроскопа равным единице. Тогда отношение сигнал/шум на выходе идеализированного

интроскопа для случая моноэнергетического излучения может быть определено по формуле [1]

$$\psi(E) = \frac{\Pi(E)}{V\Pi_\Delta(E)}, \quad (1)$$

где

$\Pi(E)$ — средняя энергия, поглощенная в мишени, при нормальном падении на нее одного кванта с энергией E ;

$\Pi_\Delta(E)$ — дисперсия поглощенной энергии.

Для мишени из селена в диапазоне энергий от 20 до 200 кэв функции $\Pi(E)$ и $\Pi_\Delta(E)$ могут быть вычислены с достаточной для практического применения точностью по формулам, полученным с учетом только первого столкновения и в предположении, что вся передаваемая электронам энергия расходуется на ионизацию непосредственно в точке столкновения:

$$\Pi(E) = \frac{1}{\mu} (1 - e^{-\mu h}) (\tau E + \sigma \bar{E}_\sigma) e^{-\mu_c h_c}, \quad (2)$$

$$\Pi_\Delta(E) = \frac{1}{\mu} (1 - e^{-\mu h}) (\tau E^2 + \sigma f_e) e^{-\mu_c h_c}, \quad (3)$$

где

τ и σ — линейные коэффициенты фотоэффекта и комптоновского рассеяния для материала мишени;

h и h_c — толщина полупроводникового слоя мишени и стеклянной планшайбы рентгеновидикона соответственно;

μ и μ_c — коэффициент линейного поглощения полупроводникового слоя мишени и стеклянной планшайбы рентгеновидикона;

E_σ и f_e — энергия, передаваемая электрону отдачи в среднем за один акт комптоновского рассеяния и дисперсия этой энергии.

Формулы, определяющие \bar{E}_σ и f_e , приведены в литературе [1, 2].

Для материала мишени из окиси свинца в области энергий до 200 кэв при расчете функций $\Pi(E)$ и $\Pi_\Delta(E)$ необходимо учитывать энергию, выносимую характеристическими квантами, возникшими при фотоэффекте на K -оболочке атомов свинца. В этом случае функцию $\Pi(E)$ удобно представить в виде двух функций

$$\Pi(E) = \Pi_1(E) + \Pi_x(E) e^{-\mu_c h_c}, \quad (4)$$

где

$\Pi_1(E)$ учитывает поглощенную в мишени энергию при условии, что все характеристические кванты вылетают из мишени. При энергии падающих квантов, меньших 200 кэв, и малых толщинах полупроводникового слоя функцию $\Pi_1(E)$ можно вычислить с точностью, достаточной для практического применения, по формуле, полученной с учетом только первого столкновения

$$\Pi_1(E) = \frac{1}{\mu} (1 - e^{-\mu h}) (\tau E - \tau_k E_k + \sigma \bar{E}_\sigma) e^{-\mu_c h_c}, \quad (5)$$

где

τ — коэффициент фотопоглощения только за счет фотоэффекта на K -оболочке атомов свинца.

Предполагая, что соотношение между τ и τ_k во всем интервале энергий сохранится таким же, как и в области скачка, для окиси свинца можно записать $\tau_k = 0,81\tau$.

E_k — средняя энергия характеристических квантов, для свинца $E_k = 75$ кэв.

Функция $\Pi_x(E)$ в формуле (4) учитывает энергию характеристического излучения, поглощаемую в полупроводниковом слое мишени. Так

как поглощение характеристических квантов проходит в основном за счет фотоэффекта, то функция $\Pi_x(E)$ с высокой точностью может быть определена при учете только одного столкновения. Принимая, что характеристические кванты имеют изотропное распределение, а количество образовавшихся квантов пропорционально вероятности фотоэффекта на K -оболочке атомов свинца можно получить для $\Pi_x(E)$ следующую формулу:

$$\Pi_x(E) = \tau_k E_k \left\{ \frac{1}{\mu} (1 - e^{-\mu h}) + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(e^{-\frac{\mu_x h}{y}} - e^{-\mu h})}{\frac{\mu_x}{y} - \mu} dy - \right. \\ \left. - \frac{1}{2} \int_{-1}^0 \frac{[e^{h(\frac{\mu_x}{y} - \mu)} - 1]}{\frac{\mu_x}{y} - \mu} dy \right\}, \quad (6)$$

где

μ_x — коэффициент ослабления характеристического излучения в окиси свинца, в данном случае $\mu_x = 1,73 \frac{cm^2}{g}$, $y = \cos\theta$ — косинус угла между направлением первичного и характеристического квантов.

Соотношение для дисперсии поглощенной в материале мишени энергии $\Pi_\Delta(E)$ может быть получено, если считать, что все поглашающие характеристические кванты поглощаются в объеме, соответствующем одному элементу разложения. В этом случае импульс тока, возникающий в мишени из-за поглощения характеристического кванта, будет складываться с соответствующим импульсом фотоэлектрона, так как они происходят одновременно. Поэтому поглощение характеристических квантов будет просто эквивалентно уменьшению τ_k и соответственно увеличению числа полностью поглощенных квантов. Тогда функция $\Pi_\Delta(E)$ выразится как

$$\Pi_\Delta(E) = \left\{ \frac{1}{\mu} (1 - e^{-\mu h}) [\tau E^2 - E_k \tau_k (2E - E_k) + \sigma f_e] + \right. \\ \left. + \Pi_x(E) (2E - E_k) \right\} e^{-\mu_c h_c}. \quad (7)$$

По формулам (1—7) были проведены расчеты отношения сигнал/шум для идеализированных интроскопов на рентгеновидиконах с мишнями из селена толщиной 0,1 и 0,5 мм и окиси свинца толщиной 0,1 и 0,5 мм. При расчетах было принято, что плотность селена 4,8 г/см³, а плотность окиси свинца 8 г/см³ [3]. Расчеты проводились для рентгеновидиконов с торцевым стеклом толщиной $h_c = 2$ мм, состоящим из 34% кремния, 72% кальция, 10,8% натрия, 48% кислорода. Влияние сигнальной пластины при расчете не учитывалось, потому что предполагалось, что в качестве сигнальной пластины используется тонкий слой алюминия, а коэффициент ослабления излучения в алюминии и стекле примерно одинаковы. Если же в качестве сигнальной пластины применяется слой хлористого олова, то необходимо дополнительно учитывать ослабление излучения сигнальной пластиной.

Полученные в результате расчетов зависимости приведены на рис. 1, где кривые 1, 2 показывают зависимости отношения сигнал/шум идеализированных интроскопов на рентгеновидиконах с мишнями из

окиси свинца, толщиной соответственно 0,5 мм и 0,1 мм и 3, 4 — с мишениями из селена, толщиной 0,5 мм и 0,1 мм.

Из сравнения кривых 1÷4, рис. 1 видно, что идеализированные рентгеновидиконные интроскопы с мишениями из окиси свинца имеют значения отношения сигнала/шум большие, чем интроскопы с мишениями из селена при одинаковых толщинах мишени и одинаковых значениях

энергий излучения моноэнергетического источника, особенно в области энергий от 90 до 120 кэв. Так, если для одинаковых толщин мишени из селена и окиси свинца 0,5 мм в области энергий от 50 до 90 кэв разница в значениях отношения сигнала/шум составляет $\approx 25\%$, то в области энергий от 90 до 200 кэв значения отношений сигнала/шум для мишени из селена меньше в 2,5÷3 раза. В области энергий от 90 до 200 кэв значения отношений сигнала/шум даже для мишени из окиси свинца толщиной 0,1 мм больше значений отношения сигнала/шум для мишени из селена толщиной 0,5 мм. Второй максимум для мишени из окиси свинца и скачок при энергии 88 кэв обусловлены фотоэффектом на

Рис. 1. Отношение сигнал/шум для идеализированных интроскопов на рентгеновидиконах с мишениями из окиси свинца и селена, толщиной 0,5 и 0,1 мм, соответственно кривые 1, 2, 3, 4

К-оболочке атомов свинца. Первый максимум отношения сигнал/шум для обоих материалов мишени в области энергий 30÷50 кэв соответствует максимальной спектральной чувствительности рентгеновидиконов с мишениями из вышеуказанных материалов. Следовательно, интроскопы на основе рентгеновидиконов с мишениями из окиси свинца более перспективны, чем изготавливаемые в настоящее время с мишениями из селена. Ошибки в расчете отношения сигнал/шум по формуле (1) являются в основном систематическими и определяются ошибками, допущенными при расчете функций $\Pi(E)$ и $\Pi_d(E)$. Первая из них возникает вследствие того, что часть энергии, переданная электронам вблизи границы мишени, выносится ими за пределы мишени, а, с другой стороны, некоторая доля не учитываемой в расчете энергии переносится в мишень электронами, вылетающими из торцовой планшайбы рентгеновидикона. Однако в случае стеклянной или алюминиевой планшайбы энергия, переносимая из планшайбы, много меньше энергии, выносимой из мишени, и ее можно не учитывать. При рассматриваемых выше энергиях основной вклад в ошибку вносят фотоэлектроны, так как комптоновские электроны отдачи имеют малую энергию и малый пробег. При расчете ошибки предполагалось, что энергия выносится только фотоэлектронами, причем все фотоэлектроны летят перпендикулярно плоскости мишени и теряют свою кинетическую энергию на пути, равном максимальной глубине проникновения. Очевидно, что все эти предположения приводят к завышению ошибки, следовательно, вычисленная ошибка будет больше истинной. С учетом указанных допущений относительная ошибка расчета функции $\Pi(E)$ для мишени из селена определяется формулой

где

$$\delta = \frac{\tau I E_e \cdot 100\%}{2 \Pi(E)} e^{-\mu_c h_c}, \quad (8)$$

где

l — максимальная глубина проникновения электрона с энергией E_e в материале мишени, $E_e = E - E_{\text{св}}$, где $E_{\text{св}}$ — энергия связи электрона. При расчете предполагалось, что все фотоэлектроны выбиваются с K -оболочки, тогда $E_{\text{св}} = 13 \text{ кэв}$.

Относительная ошибка $\sqrt{\Pi_\Delta(E)}$ того же знака и, вероятно, того же порядка, что и ошибка, допущенная при вычислении функции $\Pi(E)$, а следовательно, относительная ошибка, допущенная при вычислении отношения сигнал/шум, меньше ошибки $\Pi(E)$.

Для определения относительной ошибки, допущенной при вычислении $\Pi(E)$ для мишени из окиси свинца, можно получить следующую формулу:

$$\delta = \frac{[\tau_k l_1'(E - E'_k) + l_2(\tau - \tau_k)(E - E_L) + \tau_k l_3(E'_k - E_L)]}{2\Pi(E)} 100\% e^{-\mu_c h_c}, \quad (9)$$

где

E_k^1 и E_L — энергия связи электронов на K и L — оболочках атомов свинца, равные соответственно 88 кэв и 15 кэв.

l_1 , l_2 , l_3 — экстраполированные пробеги электронов, взятые при энергиях соответственно $E - E_k^1$, $E - E_L$, $E_k^1 - E_L$ из литературы [4].

Расчет по формулам (8) и (9) дал следующие значения относительной ошибки функции $\Pi(E)$ для мишени из окиси свинца толщиной 0,1 мм: 6%, 6%, 11% соответственно для энергий 100 кэв, 150 кэв, 200 кэв и для мишени из селена толщиной 0,1 мм: 9%, 16%, 20% для тех же значений энергий. При увеличении толщины мишени относительная ошибка уменьшается обратно пропорционально поглощенной энергии (ведь абсолютная ошибка не изменяется с изменением толщины мишени).

Выводы

Приведенные расчеты показывают, что интроскопы на рентгеновидиконах с мишнями из окиси свинца должны иметь большую чувствительность, чем интроскопы на рентгеновидиконах с мишнями из селена при одинаковых толщинах мишней, особенно в диапазоне энергий 90÷200 кэв, что обусловлено высоким эффективным атомным номером материала мишени. Наличие второго максимума в зависимости $\Psi(E)$ для интроскопов на рентгеновидиконах с мишнями из окиси свинца в области энергий 100÷200 кэв позволяет предположить, что указанные интроскопы с промышленными рентгеновскими установками на 120÷200 кэв можно использовать при просвечивании изделий средней толщины — из алюминия порядка 100 мм, из стали — 30 мм.

ЛИТЕРАТУРА

1. А. П. Шагин. Кандидатская диссертация. Томск, 1967.
2. С. В. Стародубцев, А. М. Романов. Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Часть I, изд-во «Наука», Уз. ССР, Ташкент, 1964.
3. Справочник химика, Т. I, 1963.
4. L. V. Spenser. Energy Dissipation by Fast Electrons. Nat. Bur. St(US), 1959.